



## CZ Si n型・p型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Asドーブ(n型)	Sbドーブ(n型)	Phosドーブ(n型)	Boronドーブ(p型)
サイズ	2インチ 3インチ 4インチ 6インチ 8インチ			
面方位	(100)±0.5° (111)±0.5° オフアングルウエハ			

キャリア濃度 (cm-3)	N/A			
抵抗率 (Ω.cm)	≦0.003	≦0.02	0.1~50	0.001~50
EPD (Ave) (cm2)	Free			

直径 (mm)	50.0±0.5	76.0±0.5	100.0±0.5	150±0.5	200±0.5
厚さ (μm)	280±10	380±15	525±15	625±15	725±25
TTV (μm)	≦15	≦25	≦10	≦10	≦10
OF長さ (mm)	17.5±2.5	22.0±2.5	32.5±2.5	47.5±2.5	ノッチ

レーザーマーク	オプション				
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)			
	裏面	エッチド/鏡面研磨			
梱包形態	カセット (max25枚)				



## FZ・MCZ Si n型・p型 基板 標準仕様

ドーパント、導電型	Phosドーブ(n型)		Boronドーブ(p型)		
サイズ	4インチ 6インチ 8インチ				
面方位	(100)±0.5° (111)±0.5° オフアングルウエハ				

キャリア濃度 (cm-3)	N/A				
抵抗率 (Ω.cm)	20~1,000		>100		
EPD (Ave) (cm2)	Free				

直径 (mm)	—	—	100.0±0.5	150±0.5	200±0.5
厚さ (μm)	—	—	525±15	625±15	725±25
TTV (μm)	—	—	≦10	≦10	≦10
OF長さ (mm)	—	—	32.5±2.5	47.5±2.5	ノッチ

レーザーマーク	オプション				
面仕上げ	表面	鏡面研磨 (エピレディ)			
	裏面	エッチド/鏡面研磨			
梱包形態	カセット (max25枚)				

※各種ウエハーの仕様はご相談に応じます。